



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H 1959

对应国外型号
2SC1959

主要用途

作音频功率放大，激励级放大、开关应用

外形图及引脚排列

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	—— 贮存温度.....	-55~150
T_j	—— 结温.....	150
P_C	—— 集电极耗散功率.....	500mW
V_{CBO}	—— 集电极—基极电压.....	35V
V_{CEO}	—— 集电极—发射极电压.....	30V
V_{EBO}	—— 发射极—基极电压.....	5V
I_C	—— 集电极电流.....	500mA
I_B	—— 基极电流.....	100mA



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{CB}=35V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{EB}=5V, I_C=0$
$h_{FE(1)}$	直流电流增益	70		400		$V_{CE}=1V, I_C=100mA$
$h_{FE(2)}$		25				$V_{CE}=6V, I_C=400mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		0.1	0.25	V	$I_C=100mA, I_B=10mA$
V_{BE}	基极—发射极电压		0.8	1.0	V	$V_{CE}=1V, I_C=100mA$
f_T	特征频率		300		MHz	$V_{CE}=6V, I_C=20mA$
C_{ob}	共基极输出电容		7		pF	$V_{CB}=6V, I_E=0, f=1\text{ MHz}$

分档及其标志

HFE (1)	0	Y	GR
	70—140	120—240	200—400
HFE (2)	0	Y	
	25 (Min)	40 (Min)	



特性曲线

